# «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет електроніки Кафедра мікроелектроніки

# Звіт з виконаної практичної роботи №1

з курсу «Технологічні основи електроніки» "Визначення питомого опору чотирьохзондовим методом" Варіант №6

> Виконав: Студент III курсу групи ДП-82 Мнацаканов Антон

Перевірив: доц. Мачулянський О.В.

## Обираємо експериментально визначені значення:

Значення відстаней  $S_1, S_2, S_3$  між зондами

6 1,13 1,24 1,13

Значення різниці потенціалів між зондами №2 та №3

 $6 \mid 3 \cdot 10^{-1} \mid 7 \cdot 10^{-1} \mid 3 \cdot 10^{-1}$ 

Значення електричного струму, що протікає між зондами №1 та №4

 $6 \mid 1 \cdot 10^{-2} \mid 7 \cdot 10^{-2} \mid 3 \cdot 10^{-2}$ 

### ⊙ 2. Проводимо статистичну обробку результатів дослідження:

При різних S:

 $\rho 1 = 20.355240207045547$ 

 $\rho 2 = 6.785080069015181$ 

 $\rho 3 = 20.355240207045547$ 

При однакових S = 0.113(cm):

 $\rho 1 = 21.299998191338798$ 

 $\rho 2 = 7.099999397112931$ 

 $\rho 3 = 21.299998191338798$ 

При  $S = S \pm 20\%$ :

 $\rho 1 = 28.649667896921635$ 

 $\rho 2 = 9.549889298973877$ 

 $\rho 3 = 28.649667896921635$ 

Значення точкової оцінки вимірюваної величини:

 $\widetilde{m} = 15.8318534944$ 

Значення оцінки середньокв-го відхилення одиничного вимірювання серед п вимірів:

 $\tilde{\sigma} = 6.39703483693$ 

Значення оцінки середньок-го відхилення середнього арифметичного виконаних вимірів:

 $\widetilde{\sigma}_0 = 3.69332978511$ 

Вважаючи, що довірча ймовірність  $\rho_{dov} = 0.95$  знаходимо квантиль:

 $t_s(0.975, 2)$ 

Значення півширини довірчого інтервалу:

 $\delta_{\rho} = 15.4842851241$ 

Значення абсцис кінців довірчого інтервалу:

m = -0.060544570979

m = 31.7242515597

#### Відносна похибка вимірювання:

 $\Delta = 100.382422507$ 

### О 3. Проводимо аналіз методу вимірювання питомого опору Ван дер Пау:

Чотирьохзондовий метод вімірювання питомої електричної провідності напівпровідників є найбільш розповсюджений, тому що не потребуе створення омічніх контактів до зразка і забезпечуе проведення вімірювань на зразок найрізноманітнішої форми та розмірів, незважаючи на те що цей метод є рушійнім(Це пов'язано з тим, що він має електричний контакт зі зразком).

В ряді випадків в метрології напівпровідників віддається перевага так званим безконтактним методам вимірювання  $\rho$ , що пов'язано з їх деякими перевагами у порівнянні з зондовими:

- 1. Не рушійною і незагрязняючою дією на зразок.
- 2. Можливістю вимірювання зразків з високим перехідним опором контактів.

**Правда, слід відмітити, що ці методи програють зондовим у точності** (Мостові методи, основані на взаємодії напівпровідника з електромагнітним полем коливального контура та НВЧ-методи).

Перевага цього методу (чотирьохзондового) полягає в тому, що для його застосування не потрібно створення омічних контактів до зразка, можливий вимір питомого опору зразків найрізноманітнішої форми й розмірів. Умовою його застосування з погляду форми зразка є наявність плоскої поверхні, лінійні розміри якої перевершують лінійні розміри системи зондів. Чотирьохзондовий метод широко використовується у технології виробництва кремнієвих інтегральних схем для контролю поверхневого опору провідних шарів у діапазоні від  $10^{-3}$  Ом до  $10^6$  Ом. До недоліків чотирьохзондового методу варто віднести наступне: чотирьохзондовий метод не є неруйнуючим, оскільки при контакті зонда з поверхнею пластини на її поверхні можуть утворюватися пошкодження (мікротріщини, царапини); неоднорідність зразка, не ідеальність струмових контактів можуть визивати утворення термічної електрорушійної напруги; зношування чотирьохзондової голівки в процесі експлуатації може привести до зміни міжзондових відстаней, відхилення зондів від прямої лінії. Останні три обставини приводять до виникнення похибки виміру питомого опогу.

### ⊙ 4. Висновок:

Висновок: при виконанні данного практичного завдання було виявлено, що при достантій якості приладів та зняття результатів (не враховуючи округлень), чотирьохзондовий метод дослідження питомого опору  $\rho$  показує достатньо гарну точність за досить короткий проміжок часу (не враховуючи підготовки), тому доцільним буде використання данного методу при дослідженнях напівпровідникових матеріалів.